

第78回 応用物理学会秋季学術講演会 福岡国際センター
薄膜・表面物理分科会企画シンポジウム
6薄膜・表面 13半導体 共催

新デバイス・材料開発のための
ナノスケール3次元分析（I）

開催：2017年9月6日(水) 13:45～17:30

会場：C19 福岡国際センター

半導体の微細化が限界を迎え、従来のシリコントランジスタに代わる素子では、特に、立体チャネル構造によるトランジスタ構造など、従来の素子とは異なる新機能や新動作原理素子が重要になる。そのため、表面分析手法としての特徴と内部を評価できる3次元解析手法としての特徴を併せ持つナノスケール3次元分析が重要になってきている。

本シンポジウムでは、新デバイスやナノスケール材料解析を念頭に、FIB-SEMIによる加工法と表面分析法の組み合わせ、アトムプローブ、TEM-STEM、X線・中性子解析など特徴的な分析手法の現状と課題、応用例などを議論する。

招待講演

高橋庸夫（北大）

ナノスケールReRAM/CBRAMデバイスのIn-situ TEM解析

土山 明（京大）

放射光マイクロ～ナノCTを用いた微細3次元構造解析：
地球外物質を例として

長 康雄（東北大）

超高次非線形誘電率顕微鏡法を用いた局所DLTS法の開発と
MOS界面評価

加藤 淳（TRC）

FIBSEMとの組み合わせによるナノスケール解析

大久保忠勝（物材機構）

レーザーアトムプローブによるナノ組織解析

田中洋毅（東芝）

新材料・新構造3D化デバイスにおけるナノスケール3D解析の
「ここまでできた」と「これができない」

世話人：橋詰富博（日立）、小川修一（東北大）、鈴木 哲（兵庫県立大）
吉村 雅満（豊田工大）、蓮沼 隆（筑波大）、小山正人（東芝）

問い合わせ先：tomihiro.hashizume.qb@hitachi.com

（※参加には応用物理学会秋季学術講演会の参加登録が必要です。）